

台灣半導體研究中心 異質整合製程組

晶圓溼式清洗系統 (Wet bench)

一. 規格: 使用的酸鹼溶液 如下

	SPM (Caro)	DHF	APM (SC-1)	HPM (SC-2)
化學品	H ₂ SO ₄ : H ₂ O ₂	HF : H ₂ O	NH ₄ OH : H ₂ O ₂ : H ₂ O	HCl : H ₂ O ₂ : H ₂ O
比例	3 : 1	1 : 50	1 : 1 : 5	1 : 1 : 6
溫度	120°C	25°C	75°C	75°C
時間	600 sec	60 sec	600 sec	600 sec

二、注意事項

1. 使用 RCA Cleaning 晶圓規格限制如下
 - 全新開封的 4 吋或 6 吋或 8 吋晶圓。
 - 嚴禁使用破片。
 - 晶圓上有任何有機或金屬結構物嚴禁使用 RCA Cleaning。
2. 使用濕式製程者一律穿著全套防護器具；並嚴禁使用者自行調配或私自取用機台內任一種化學溶液。
3. 遇有液體洩漏、火災燃燒或人員傷害等緊急狀況時，請通知緊急應變指揮中心協助處理 (分機 6601)。
4. 目前不開放使用者更改任一項製程參數，有特殊製程需要者請事先詢問機台負責工程師。
5. 預約考核請洽機台負責工程師。